

ISPlasma2013 プログラム
(2013年1月28日～2月1日 会場:名古屋大学)

1/28(月)		1/29(火)						
		(9:00-) Registration						
		開会 座長:天野 浩 (名古屋大学) 【A会場】	(9:20-9:35) 開会挨拶 【来賓挨拶】里見 朋香 (文部科学省 科学技術・学術政策局 産業連携・地域支援課長) 【主催者挨拶】加藤 伸一 (科学技術交流財団 東海広域知的クラスター創成事業本部 本部長) 【組織委員長挨拶】堀 勝 (名古屋大学 教授)					
			(9:35-9:45) 開会の辞 (Opening Talk) 大塚 美則 (科学技術交流財団 東海広域知的クラスター創成事業本部 事業総括)					
			(9:45-10:15) 知的クラスター講演 Tua-A01C 堀 勝 (名古屋大学)					
		(10:15-10:30) Break						
		特別講演・基調講演 座長:宮崎 誠一 (名古屋大学) 【A会場】	(10:30-11:10) 特別講演 Tua-A02PL 大野 英男 (東北大学) "Spintronics makes CMOS VLSI nonvolatile"					
			(11:10-11:40) 基調講演 Tua-A03K J. G. Han (Sungkyunkwan Univ., Korea) "Challenge of plasma-nano technology for next generation frontier industry"					
			(11:40-12:10) 基調講演 Tua-A04K R. Ruoff (The Univ. of Texas at Austin, USA), L. Colombo (Texas Instruments Inc., USA) "Graphene and h-BN at the Interface"					
(12:30-) Registration		(12:10-13:20) Lunch						
チュートリアル プラズマ科学 座長:豊田 浩孝 (名古屋大学) 【C会場】	(13:00-13:45) L. Overzet (The Univ. of Texas at Dallas, USA) "Fundamental aspects of high aspect ratio silicon etching"	(13:20-14:50) ポスターセッション 1						
	(13:45-14:30) 佐々木 浩一 (北海道大学) "Introduction to advanced plasma diagnostics for material processing"	移 動						
		プラズマ科学1 プラズマ源と計測 I 座長:P. Chabert (LPP, CNRS Ecole Polytechnique, France) 【A会場】	(14:55-15:20) 招待講演 Tup-A01IA U. Czarnetzki (Ruhr Univ., Bochum, Germany) "Structured electrodes: Denser and more homogeneous plasmas" (15:20-15:40) Tup-A02OA M. Shiratani (Kyushu Univ., Japan) "Time evolution of nanoparticle size in reactive plasmas: Comparison between theory and experiments"	窒化物半導体1 窒化物結晶成長 I 座長:天野 浩 (名古屋大学) 【B会場】	(14:55-15:20) 招待講演 Tup-B01IB R. Dwilinski (Ammono Company, Poland) "Bulk GaN substrates grown by ammonothermal method" (15:20-15:40) Tup-B02OB S. Kitagawa (Mie Univ., Japan) "Growth of thick AlN on 6H-SiC substrate by low-pressure HVPE"	ナノ材料1 ナノカーボンおよび ナノ材料応用 座長:平松 美根男 (名城大学) 【C会場】	(14:55-15:20) 招待講演 Tup-C01IC I. Lee (Chonbuk National Univ., Korea) "Localized surface plasmon mediated nanopillar light-emitting diode by Ag and Ag/SiO ₂ nanoparticles" (15:20-15:40) Tup-C02OC Y. Wang (National Cheng Kung Univ., Taiwan) "N-channel organic memory devices with TiO ₂ nanoparticles/polyimide insulator blends: Extra-high memory window"	
(14:30-14:40) Break								
チュートリアル 窒化物半導体 座長:若原 昭浩 (豊橋技術科学大学) 【C会場】	(14:40-15:25) J. Duboz (CRHEA-CNRS, France) "Light matter interaction in GaN"	(15:40-16:00) Tup-A03OA R. W. Boswell (Space Plasma Power and Propulsion Laboratory, ANU, Australia) "Ideal low electron temperature plasma reactor"		(15:40-16:00) Tup-B03OB Y. Tomita (LayTec AG, Germany) "Strain engineering using in-situ curvature measurements and reduction of plastic deformation during the growth of GaN on various Si substrates"		(15:40-16:00) Tup-C03OC K. Nagashio (The Univ. of Tokyo, Japan) "Extraction of quantum capacitance in monolayer graphene"		
	(15:25-16:10) 名西 徳之 (立命館大学・Seoul National Univ., Korea) "Recent developments in growth of InN and In-rich InGaN and future prospect"	(16:00-16:20) Tup-A04OA Y. Yang (National Chiao Tung Univ., Taiwan) "A cold planar nitrogen atmospheric-Pressure plasma jet with enhanced UV emission and radical generation using short electrodes"		(16:00-16:20) Tup-B04OB I. Shin (Seoul National Univ., Korea) "Improved crystalline quality of low temperature GaN by using a pre-deposited indium layer"		(16:00-1620) Tup-C04OC Y. Ding (Tokyo Inst. of Tech., Japan) "Silicon nanocrystal fabrication by using non-thermal plasma and application to hybrid Si-nanocrystal/P3HT solar cells"		
(16:20-16:40) Break								
		プラズマ科学2 プラズマ源と計測 II 座長:U. Czarnetzki (Ruhr Univ., Bochum, Germany) 【A会場】	(16:40-17:05) 招待講演 Tup-A05IA P. Chabert (LPP, CNRS Ecole Polytechnique, France) "Modeling of atmospheric capacitive discharges in He/O ₂ " (17:05-17:25) Tup-A06OA N. Nishizawa (Nagoya Univ., Japan) "Ultrafast near-infrared spectroscopy using fiber laser based wavelength tunable narrow-linewidth source"	窒化物半導体2 窒化物結晶成長 II 座長:R. Dwilinski (Ammono Company, Poland) 【B会場】	(16:40-17:05) 招待講演 Tup-B05IB W. Walukiewicz (Lawrence Berkeley National Lab., USA) "In-rich group III-nitride alloys for solar power utilization devices" (17:05-17:25) Tup-B06OB Y. Kawai (Nagoya Univ., Japan) "Enhancement of growth rate in GaN homoeopitaxy by plasma-assisted molecular beam epitaxy using high-density nitrogen radical source"	ナノ材料2 中空、ポーラス材料 座長:牧原 克典 (名古屋大学) 【C会場】	(16:40-17:05) 招待講演 Tup-C05IC T. Wei (Chung-Yuan Univ., Taiwan) "Rapid grafting of anti-biofouling and environment-responsive polymers by atmospheric-pressure plasmas" (17:05-17:25) Tup-C06OC F. Fracassi (Univ. of Bari, Italy) "Investigation of atmospheric pressure plasma-enhanced chemical vapor deposition from methylidisiloxane precursors"	
		(17:25-17:45) Tup-A07OA A. Pandey (Chubu Univ., Japan) "Curling probe monitoring of plasma CVD and wall cleaning processes"		(17:25-17:45) Tup-B07OB T. Kumada (Tohoku Univ., Japan) "Influence of N ₂ gas flow ratio on crystalline quality of Al-polar AlN layer deposited using reactive magnetron sputtering"		(17:25-17:45) Tup-C07OC W. Diono (Nagoya Univ., Japan) "Direct formation of composite hollow nano-microfibers from polymer by electrospinning"		
移 動								
(18:00-19:30) ウェルカムパーティー 【名古屋大学 野依記念学術交流館】								

ISPlasma2013 プログラム
(2013年1月28日～2月1日 会場:名古屋大学)

1/30(水)					
(9:10-) Registration					
プラズマ科学3 薄膜の堆積と改質 座長:近藤 博基 (名古屋大学) 【A会場】	(9:20-9:45) 招待講演 Wea-A01IA J. Duh (National Tsing Hua Univ., Taiwan) "From nanocomposite nitride to novel thin film metallic glass"	窒化物半導体3 光デバイス 座長:E. Monroy (CEA-Grenoble, France) 【B会場】	(9:20-9:45) 招待講演 Wea-B01IB M. Pristovsek (Univ. of Cambridge, UK) "Low-cost high-efficiency GaN LEDs grown on 6-inch silicon"	ナノ材料3 ナノバーティクル・ナノワイア・ナノロッド 座長:野崎 智洋 (東京工業大学) 【C会場】	(9:20-9:45) 招待講演 Wea-C01IC C. Liu (Tianjin Univ, China) "Fabrication of metallic nano particles and nano composites via glow discharge plasma reduction: Current status and perspective"
	(9:45-10:05) Wea-A02OA W. Song (The Univ. of Tokyo, Japan) "Oxidation kinetics of Ge by oxygen radicals"		(9:45-10:05) Wea-B02OB T. Fujita (Panasonic Corporation, Japan) "Design of light-extracting texture and anisotropic dry etching of m-plane GaN LED"		(9:45-10:05) Wea-C02OC K. Koga (Kyushu Univ., Japan) "Single particle trapping in plasmas using laser for studying interaction between a fine particle and palsams"
	(10:05-10:25) Wea-A03OA H. Yamada (Diamond Research Lab. AIST, Japan) "Uniformity of the growth of single-crystal diamond wafers over inch size area by using reactive microwave plasma CVD"		(10:05-10:25) Wea-B03OB S. Kim (Korea Photonics Tech. Inst. (KOPTI), Korea) "High efficiency InGaN light-emitting diodes by using air void embedded SiO ₂ mask template"		(10:05-10:25) Wea-C03OC M. H. Mamat (Univ. Teknologi MARA, Malaysia) "Fabrication of high performance ZnO nanorod array-based UV photoconductive sensor by RF magnetron sputtering at different oxygen flow rates"
(10:25-10:45) Break		(10:25-10:45) Break		(10:25-10:45) Break	
分野間融合1 カーボン先端材料 座長:須田 善行 (豊橋技術科学大学) 【A会場】	(10:45-11:15) 基調講演 Wea-A04KD Y. Lee (Sungkyunkwan Univ., Korea) "Observing graphene grain boundary by optical microscopy"				
	(11:15-11:40) 招待講演 Wea-A05ID 山崎 聡 (産業技術総合研究所) "Diamond film growth and electronic devices"				
	(11:40-12:00) Wea-A06OD K. Higuchi (Nagoya Univ., Japan) "High-mobility carbon nanotube thin-film transistors fabricated on plastic film with flexographic printing technique"				
(12:00-13:00) Lunch					
(13:00-14:30) ポスターセッション 2					
産学官連携1 名古屋からイノベーションを考える 座長:関根 誠 (名古屋大学) 【A会場】	(14:30-15:10) 基調講演 Wep-A01KE 藤村 修三 (東京工業大学) "Management of technology for forming a global innovation base and developing human resources"				
	(15:10-15:40) 基調講演 Wep-A02KE J. De Boeck (IMEC, Belgium) "Open innovation in nano-electronics through a global industrial partnership"				
	(15:40-16:10) 基調講演 Wep-A03KE 山口 栄一 (同志社大学) "Three types of breakthrough innovations for creating future industries"				
	(16:10-16:40) 基調講演 Wep-A04KE P. Feraboli(Automobili Lamborghini Laboratory at the Univ. of Washington, USA) "Conducting industrial R&D in academia: Challenges and opportunities"				
(16:40-16:50) Break					
産学官連携2 座長:藤村 修三 (東京工業大学) 【A会場】	(16:50-18:20) パネルディスカッション 名古屋からイノベーションを考える ～グローバルイノベーション拠点形成に向けて～ ◆モデレーター 藤村 修三 (東京工業大学) ◆パネリスト J. De Boeck (IMEC, Belgium) P. Feraboli(Automobili Lamborghini Laboratory at the Univ. of Washington, USA) 金澤 洋平 (三菱UFJモルガンスタンレー証券) 川口 盛之助 (アーサー・D・リトルジャパン) 山口 栄一 (同志社大学) 堀 勝 (名古屋大学)				
	移 動				
(19:00-20:30) パンケット 【名古屋大学 南部食堂】					

同時通訳あり

参加費無料

ISPlasma2013 プログラム
(2013年1月28日～2月1日 会場:名古屋大学)

1/31(木)					
(9:10-) Registration					
プラズマ科学4 エッチングプロセス 座長: L. Overzet (The Univ. of Texas at Dallas, USA) 【A会場】	(9:20-9:45) 招待講演 Tha-A011A A. Eppler (Lam Research Corporation, USA) "Pulsed plasma applications in etch"	窒化物半導体4 欠陥評価 座長: B. Daudin (CEA-Grenoble, France) 【B会場】	(9:20-9:45) 招待講演 Tha-B011B P. Ruterana (CIMAP UMR 8252 CNRS, ENSICAEN, CEA, France) "Mechanisms of damage formation during Rare Earth ion implantation in nitride semiconductors"	ナノ材料4 表面改質・表面機能化 座長: 嶋 睦宏(岐阜大学) 【C会場】	(9:20-9:45) 招待講演 Tha-C011C J. Cheng (IBM Almaden Research Center, USA) "Extending patterning capability using directed self-assembly"
	(9:45-10:05) Tha-A020A S. Kumagai (Toyota Technological Inst., Japan) "3D wiring of vertically etched photo cell Islands for high voltage generation"		(9:45-10:05) Tha-B020B A. Koizumi (Osaka Univ., Japan) "Luminescence properties of Eu-doped GaN grown by organometallic vapor phase epitaxy using a new Eu precursor bis(n-propyltetramethylcyclopentadienyl) europium"		(9:45-10:05) Tha-C020C E. Yang (Shizuoka Univ., Japan) "Enhanced surface functionalization of graphite-encapsulated nanoparticles by RF plasma with Pulsed-biasing powder blowing method"
	(10:05-10:25) Tha-A030A R. Kometani (Nagoya Univ., Japan) "High temperature plasma etching of GaN"		(10:05-10:25) Tha-B030B H. Nykanen (Aalto Univ., Finland) "Degradation of optical properties of epitaxial GaN induced by vacancy activation under low energy electron beam irradiation"		(10:05-10:25) Tha-C030C W. Kuo (National Taiwan Univ. of Science and Tech., Taiwan) "Surface modification using zwitterionic and PEG based copolymers to improve hemocompatibility"
(10:25-10:45) Break		(10:25-10:45) Break		(10:25-10:45) Break	
プラズマ科学5 プラズマバイオおよび医療 座長: 水野 彰 (豊橋技術科学大学) 【A会場】	(10:45-11:10) 招待講演 Tha-A041A A. Fridman (Drexel Univ., USA) "Plasma medicine: Fundamental physical and biochemical mechanisms of direct plasma interaction with living tissues."	窒化物半導体5 電子デバイス 座長: 名西 徳之 (立命館大学・Seoul National Univ., Korea) 【B会場】	(10:45-11:10) 招待講演 Tha-B041B 藤原 徹也(ローム) "Plasma-process on GaN-based field-effect transistors"	ナノ材料5 ナノ機能材料 座長: 佐藤 尚(名古屋工業大学) 【C会場】	(10:45-11:10) 招待講演 Tha-C041C H. Kwon (EMPA, Switzerland) "Functionally graded dual-nanoparticle-reinforced metal matrix composites"
	(11:10-11:30) Tha-A050A P. Favia (Inst. For Inorganic Methodologies & Plasmas (IMIP)-CNR, Italy) "Surface modification of 3D porous scaffolds for Tissue Engineering by means of different plasma processes"		(11:10-11:30) Tha-B050B D. C. Peter Raj (Nagoya Inst. of Tech., Japan) "Fabrication of AlGaIn/GaN HEMTs on 200 mm Si (111) substrate"		(11:10-11:30) Tha-C050C B. Liaw (National Taiwan Univ. of Science and Tech., Taiwan) "Sythesis of high index facets nanoparticles for cholesterol sensing"
	(11:30-11:50) Tha-A060A S. Maruyama (Nagoya Univ., Japan) "Potential of adipose tissue-derived stem cells and low temperature physical plasma for use in regenerative medicine"		(11:30-11:50) Tha-B060B S. Ozaki (Fujitsu Laboratories Ltd., Japan) "Effect of ALD method on threshold voltage shift in AlGaIn/GaN MIS-HEMTs"		(11:30-11:50) Tha-C060C M. A. Bratescu (Nagoya Univ., Japan) "Graphene decorated with gold bimetallic nanoparticles in solution plasma"
(11:50-13:00) Lunch					
(13:00-14:30) ポスターセッション 3					
分野間融合2 窒化物半導体の最先端技術 座長: 加地 徹 (豊田中央研究所) 【A会場】	(14:30-15:00) 基調講演 Thp-A01KD N. Grandjean (EPFL, Switzerland) "Advanced nitride semiconductors"				
	(15:00-15:25) 招待講演 Thp-A02ID B. Daudin (CEA-Grenoble, France) "AlGaIn and InGaIn Nanowire heterostructures grown by plasma-assisted molecular beam epitaxy"				
	(15:25-15:50) 招待講演 Thp-A03ID 藤岡 洋(東京大学生産技術研究所) "Characteristics of GaN devices prepared by pulsed sputtering"				
	(15:50-16:15) 招待講演 Thp-A04ID 吉川 俊英(富士通研究所) "GaN HEMT for high frequency amplifier and power conversion"				
	(16:15-16:40) 招待講演 Thp-A05ID K. Chen (The Hong Kong Univ. of Science and Tech., China) "Device technology for GaN mixed-signal integrated circuits"				
(16:40-17:00) Break					
分野間融合3 窒化物半導体の将来展望 ～プラズマ科学、ナノテクノロジーによるレポリューション～ 座長: 分島 彰男 (名古屋工業大学) 【A会場】	(17:00-18:15) パネルディスカッション ◆モデレーター 小田 修(名古屋工業大学) ◆パネリスト K. Chen (The Hong Kong Univ. of Science and Tech., China) B. Daudin (CEA Grenoble, France) 藤岡 洋(東京大学生産技術研究所) N. Grandjean (EPFL, Switzerland) 加納 浩之 (NU エコ・エンジニアリング) 吉川 俊英(富士通研究所) I. Lee (Chonbuk National Univ., Korea) 名西 徳之(立命館大学・Seoul National Univ., Korea) M. Pristovsek (Univ. of Cambridge, UK)				

ISPlasma2013 プログラム
(2013年1月28日～2月1日 会場:名古屋大学)

2/1(金)					
(9:10-) Registration					
プラズマ科学6 新規プラズマ 座長:大野 哲靖 (名古屋大学) 【A会場】	(9:20-9:45) 招待講演 Fra-A01IA M. C. M. van de Sanden (Dutch Inst. for Fundamental Energy Research, The Netherlands) "Power efficient plasma activation of CO ₂ "	窒化物半導体6 ナノ構造先進プロセス 座長:W. Walukiewicz (Lawrence Berkeley National Lab., USA)	(9:20-9:45) 招待講演 Fra-B01IB E. Monroy (CEA-Grenoble, France) "Single GaN-based nanowires for photodetection and sensing applications"	ナノ材料6 エネルギー創造・貯 蔵デバイス 座長:錦谷 禎範 (JX 日鉱日石エネル ギー)	(9:20-9:45) 招待講演 Fra-C01IC 中山 将伸 (名古屋工業大学) "Fabrication and electrochemical property of all solid-state Li polymer rechargeable battery"
	(9:45-10:05) Fra-A02OA E. Stamate (Technical Univ. of Denmark, Denmark) "Plasma assisted RF sputtering of lithium phosphorous oxynitride thin films for all-solid- state lithium ion batteries" (10:05-10:25) Fra-A03OA S. Cho (Tohoku Univ., Japan) "Control of plasma potential and fullerene clustering for high yield synthesis of nitrogen endohedral fullerene"	【B会場】	(9:45-10:05) Fra-B02OB W. Khalfaoui (Univ. François RABELAIS de Tours, France) "GaN surface protection during RTA annealing with GaON cap-layer"	【C会場】	(9:50-10:05) Fra-C02OC M. Seki (The Univ. of Tokyo, Japan) "Energy conversion between exciton and plasmon in ZnO quantum wells and Ag nanoparticles"
	(10:05-10:25) Fra-B03OB Y. Hua (National Cheng Kung Univ., Taiwan) "GaN schottky barrier photodetectors with a lattice-matched Al _{0.82} In _{0.18} N intermediate layer"		(10:05-10:25) Fra-C03OC G. D. Temmerman (Dutch Inst. For Fundamental Energy Research, Netherlands) "Efficient nanostructuring of metals by low energy helium ions for advanced energy materials"		
レイトニュース プラズマ科学 座長:大野 哲靖 (名古屋大学) 【A会場】	(10:25-10:45) Fra-A04OLNA I. Suhariadi (Kyushu University) "Effects of nitrogen on crystal growth of sputter-deposited ZnO films for transparent conducting oxide"	レイトニュース 窒化物半導体 座長:久保 俊晴 (名古屋工業大学) 【B会場】	(10:25-10:45) Fra-B04OLNB J. Birch (Linköping Univ.) "High quality GaN nanorods grown by liquid- target reactive magnetron sputter epitaxy"	レイトニュース ナノ材料 座長:平松 美根男 (名城大学) 【C会場】	(10:25-10:45) Fra-C04ONC N. Min (Korea Univ.) "Multi-walled carbon nanotube-mediated enhancement of photogenerated electron transport in a plasma-treated MWCNTs/TiO ₂ nanopowders hybrid electrode formed by one-step spray coating for dye-sensitized solar cells"
移動					
(10:50-12:20) ポスターセッション 4					
(12:20-13:30) Lunch					
エネルギーセッション1 エネルギー革命 座長:平松 美根男 (名城大学) G. Kalita(名古屋工業大学)	(13:30-14:00) 基調講演 Frp-A01KD 野崎 智洋 (東京工業大学) "Plasma catalysis for next generation C ₁ -Chemistry"				
【A会場】	(14:00-14:25) 招待講演 Frp-A02ID 錦谷 禎範 (JX日鉱日石エネルギー) "Recent developments and future prospects for organic solar cells"				
	(14:25-14:50) 招待講演 Frp-A03ID I. Mukhopadhyay (Pandit Deendayal Petroleum Univ., India) "Recent development in solar power in gujarat: Case study for large power plant and solar city"				
	(14:50-15:20) 基調講演 Frp-A04KD L. Shaw (Illinois Inst. of Tech., USA) "Energy storage enabled by nanomaterials and advanced processing"				
(15:20-15:30) Break					
エネルギーセッション2 エネルギー革命 座長:野崎 智洋 (東京工業大学)	(15:30-16:45) パネルディスカッション 高効率エネルギー利用社会の構築に向けて ◆モデレーター 野崎 智洋 (東京工業大学) ◆パネリスト 松本 毅 (大阪ガス) I. Mukhopadhyay (Pandit Deendayal Petroleum Univ., India) 中山 将伸 (名古屋工業大学) 錦谷 禎範 (JX日鉱日石エネルギー) L. Shaw (Illinois Inst. of Tech., USA) W. Walukiewicz (Lawrence Berkeley National Lab., USA)				
【A会場】					
アワード表彰	(16:45-16:55) アワード表彰 授与:堀 勝 (組織委員長) 発表:若原 昭浩 (プログラム委員長) 司会:TBA				
(16:55-17:00) 閉会					